

## 4A、650V N沟道增强型场效应管

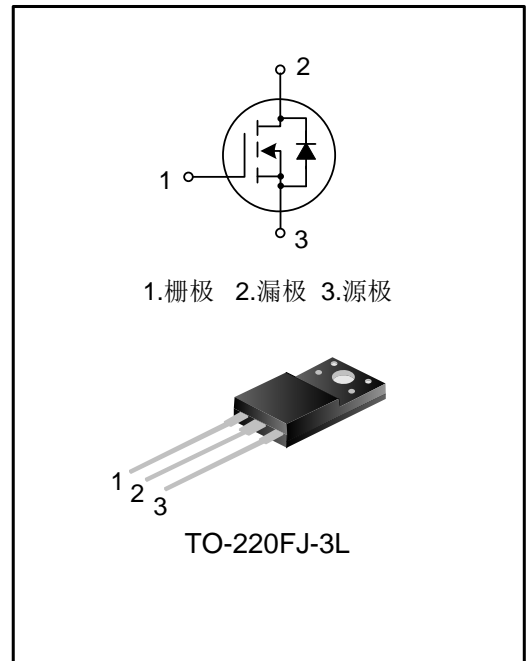
### 描述

SVF4N65CAFJ N 沟道增强型高压功率 MOS 场效应晶体管采用士兰微电子的 F-Cell™ 平面高压 VDMOS 工艺技术制造。先进的工艺及原胞结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。

该产品可广泛应用于 AC-DC 开关电源，DC-DC 电源转换器，高压 H 桥 PWM 马达驱动。

### 特点

- ◆ 4A, 650V,  $R_{DS(on)}$  (典型值) =  $2.3\Omega @ V_{GS}=10V$
- ◆ 低栅极电荷量
- ◆ 低反向传输电容
- ◆ 开关速度快
- ◆ 提升了 dv/dt 能力



### 产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装方式
SVF4N65CAFJ	TO-220FJ-3L	4N65CAFJ	无卤	料管

**极限参数(除非特殊说明,  $T_c=25^\circ\text{C}$ )**

参数	符号	参数范围	单位
漏源电压	$V_{DS}$	650	V
栅源电压	$V_{GS}$	$\pm 30$	V
漏极电流	$I_D$	$T_c=25^\circ\text{C}$	4.0
		$T_c=100^\circ\text{C}$	2.5
漏极脉冲电流	$I_{DM}$	16	A
耗散功率 ( $T_c=25^\circ\text{C}$ ) - 大于 $25^\circ\text{C}$ 每摄氏度减少	$P_D$	30	W
		0.24	W/ $^\circ\text{C}$
单脉冲雪崩能量 (注 1)	$E_{AS}$	215	mJ
工作结温范围	$T_J$	$-55\sim+150$	$^\circ\text{C}$
贮存温度范围	$T_{stg}$	$-55\sim+150$	$^\circ\text{C}$

**热阻特性**

参数	符号	参数范围	单位
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	4.17	$^\circ\text{C/W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	62.5	$^\circ\text{C/W}$

**关键特性参数(除非特殊说明,  $T_c=25^\circ\text{C}$ )**

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	$B_{V_{DS}}$	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu\text{A}$	650	--	--	V
漏源漏电流	$I_{DSS}$	$V_{DS}=650V, V_{GS}=0V$	--	--	1.0	$\mu\text{A}$
栅源漏电流	$I_{GSS}$	$V_{GS}=\pm 30V, V_{DS}=0V$	--	--	$\pm 100$	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu\text{A}$	2.0	--	4.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=2.0A$	--	2.3	2.7	$\Omega$
输入电容	$C_{iss}$	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V,$ $f=1.0\text{MHz}$	--	430	--	pF
输出电容	$C_{oss}$		--	55	--	
反向传输电容	$C_{rss}$		--	4.1	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=325V, V_{GS}=10V,$ $R_G=25\Omega, I_D=4A$ (注 2, 3)	--	9.93	--	ns
开启上升时间	$t_r$		--	25.6	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	27.6	--	
关断下降时间	$t_f$		--	25.6	--	
栅极电荷量	$Q_g$	$V_{DD}=520V, V_{GS}=10V, I_D=4A,$ (注 2, 3)	--	12.5	--	nC
栅极-源极电荷量	$Q_{gs}$		--	2.74	--	
栅极-漏极电荷量	$Q_{gd}$		--	6.31	--	

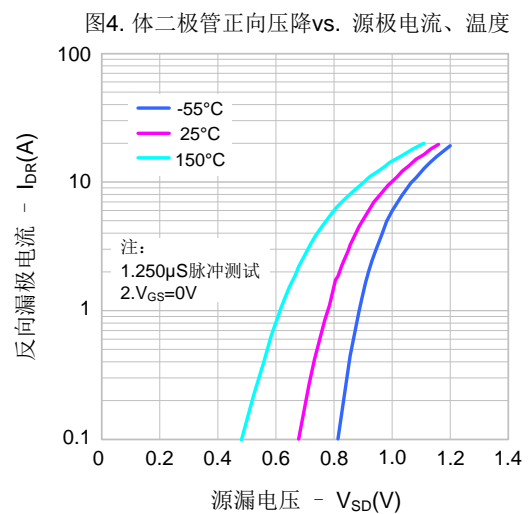
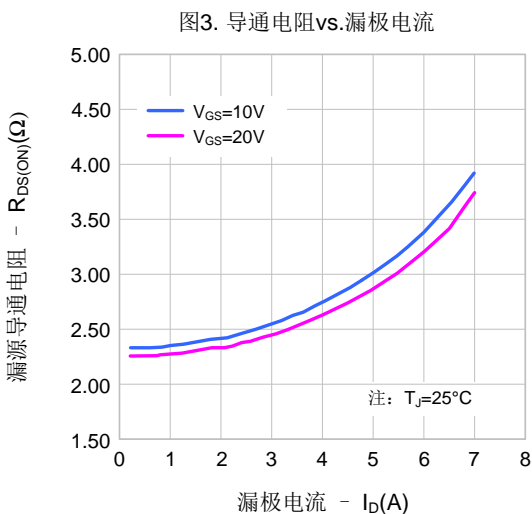
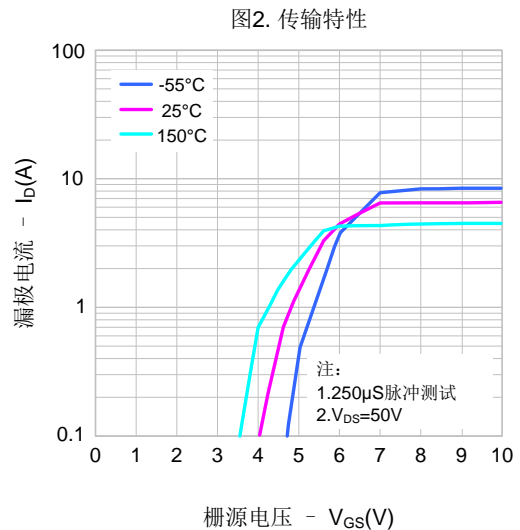
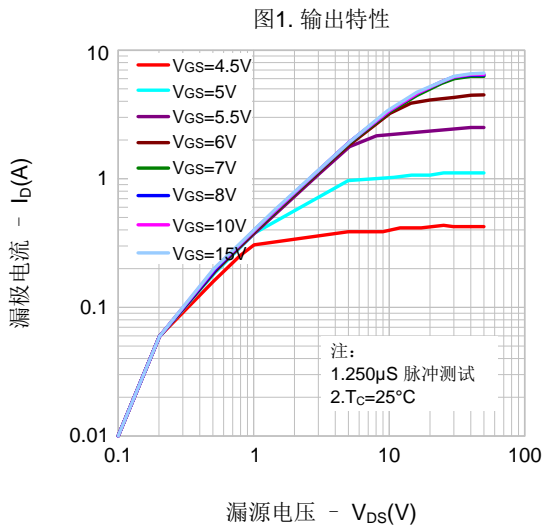
源-漏二极管特性参数

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
源极电流	$I_S$	MOS 管中源极、漏极构成的反偏	--	--	4.0	A
源极脉冲电流	$I_{SM}$	P-N 结	--	--	16	
源-漏二极管压降	$V_{SD}$	$I_S=4.0A, V_{GS}=0V$	--	--	1.4	V
反向恢复时间	$T_{rr}$	$I_S=4.0A, V_{GS}=0V,$	--	450	--	ns
反向恢复电荷	$Q_{rr}$	$dI_F/dt=100A/\mu s$ (注 2)	--	1.87	--	$\mu C$

注:

1.  $L=30mH, I_{AS}=3.6A, V_{DD}=100V, R_G=25\Omega$ , 开始温度  $T_J=25^\circ C$ ;
2. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$ , 占空比 $\leq 2\%$ ;
3. 基本上不受工作温度的影响。

典型特性曲线



典型特性曲线 (续)

图5. 电容特性

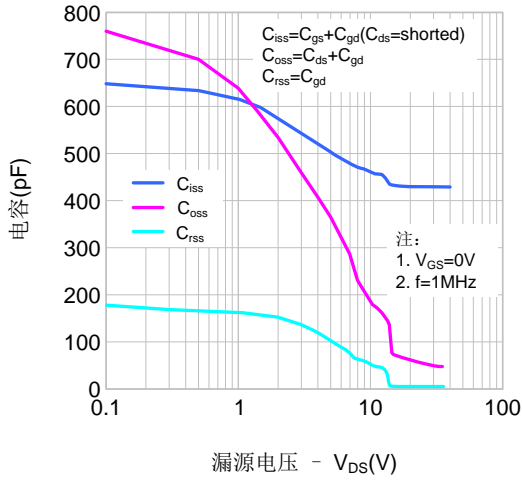


图6. 电荷量特性

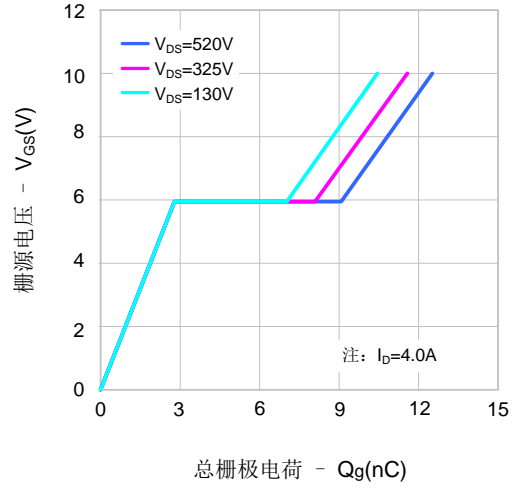


图7. 击穿电压vs.温度特性

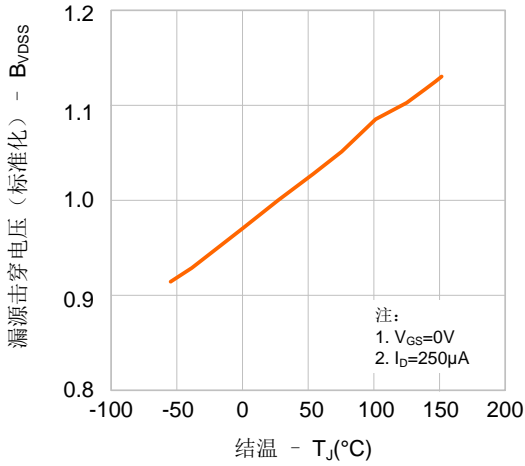


图8. 导通电阻vs.温度特性

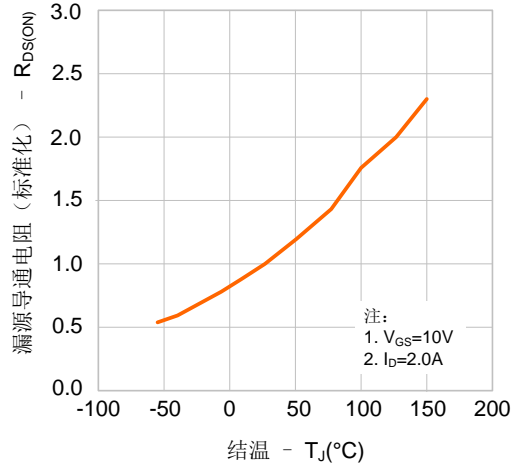


图9. 最大安全工作区域

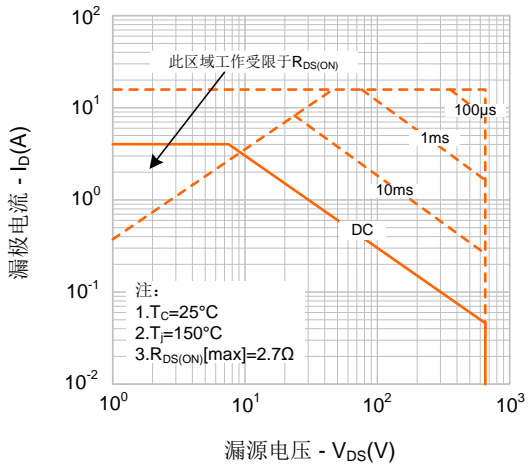
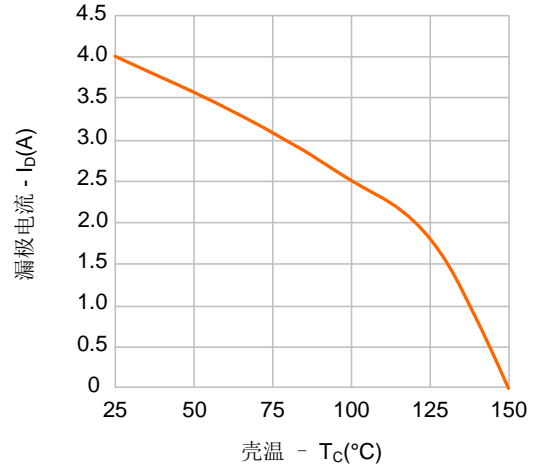
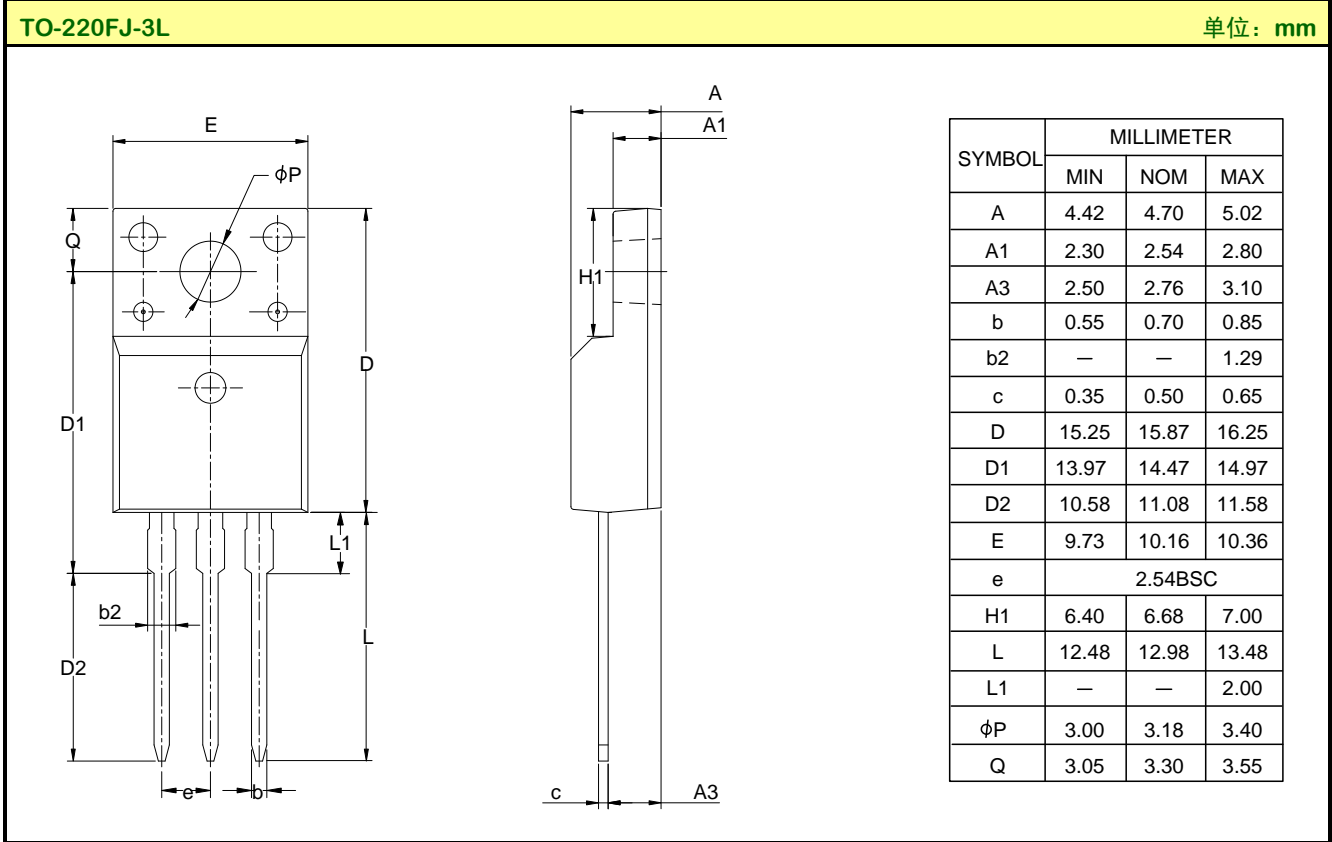


图10. 最大漏极电流vs.壳温



封装外形图



**重要注意事项:**

- 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知。客户在下单前应获取我司最新版本资料，并验证相关信息是否最新和完整。
- 我司产品属于消费类和/或民用类电子产品。
- 在应用我司产品时请不要超过产品的最大额定值，否则会影响整机的可靠性。任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用我司产品进行系统设计、试样和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。
- 购买产品时请认清我司商标，如有疑问请与本公司联系。
- 转售、应用、出口时请遵守中国、美国、英国、欧盟等国家、地区和国际出口管制法律法规。
- 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！
- 我司网站 <http://www.silan.com.cn>

---

产品名称:	SVF4N65CAFJ	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	<a href="http://www.silan.com.cn">http://www.silan.com.cn</a>

---

版 本: 1.2

修改记录:

1. 删除命名规则
  2. 修改声明
- 

版 本: 1.1

修改记录:

1. 修改典型特性曲线
- 

版 本: 1.0

修改记录:

1. 正式发布版本
- 
-